



บทที่ 1

บทนำ

กระบวนการหนึ่งของการผลิตสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ ได้แก่การแพร่ซึมสาร เจือปน (Diffusion) เข้าไปในเนื้อสารกึ่งตัวนำเพื่อสร้างหัวต่อพี-เอ็น ซึ่งต้องทำในเตาแพร่ซึมที่มีอุณหภูมิสูง เป็นเวลานาน ต้องนำเอาแผ่นผลึกสารกึ่งตัวนำเข้า-ออก จากเตาอุณหภูมิสูง แผ่นผลึกสารกึ่งตัวนำ ซึ่งต้องผ่านรัฐวิสาหกรรมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหลายครั้ง เป็นเหตุให้เกิดจุดนกพร่องทางผลึกได้⁽¹⁾ การแอนนีลหัวต่อพี-เอ็น ที่ผ่านการแพร่ซึมในเตาอุณหภูมิสูง จึงเป็นกระบวนการที่จำเป็นเพื่อลดจุดบกพร่องดังกล่าว

เมื่อจะนำเอาสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำที่สร้างไปใช้งาน จะเป็นต้องสร้างขั้วต่อไฟฟ้า (Contact) ให้กับสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำนี้ การสร้างขั้วต่อไฟฟ้านั้นสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การฉาบไอโลหะบน ผิวผลึกสารกึ่งตัวนำในสูญญากาศ (Vacuum evaporation) การขูปโลหะบนผิวผลึกสารกึ่งตัวนำทั้งแบบใช้กระแสไฟฟ้า (Electroplating)⁽²⁾ และแบบไม่ใช้กระแสไฟฟ้า (Electroless)⁽³⁾ หลังจากที่ทำขั้วต่อไฟฟ้าแล้วต้องทำการแอนนีลในเตาที่มีอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ขั้วต่อที่มีคุณภาพดีทั้งทางคุณลักษณะทางกายภาพและไฟฟ้า กล่าวคือมีความติดแน่นดี และเป็นแบบໂอห์มมิก

การแอนนีลหัวต่อพี-เอ็น และขั้วต่อไฟฟ้าที่ขอบบน ผิวผลึกสารกึ่งตัวนำนี้ นอกจากจะกระทำในเตาอุณหภูมิสูงแล้ว ยังสามารถที่จะแอนนีลได้โดยใช้แสงเลเซอร์แบบคิว-สวิทช์ ที่มีพลังงานขนาดที่เหมาะสม⁽⁴⁾ ได้มีการทดลองแอนนีลขั้วต่อไฟฟ้าที่ทำด้วยวิธีขึมนิเกลแบบใช้กระแสไฟฟ้าและไม่ใช้กระแสไฟฟ้าบนแผ่นผลึกซิลิโคนที่มีหัวต่อพี-เอ็น ด้วยแสงเลเซอร์แบบคิว-สวิทช์ จากเลเซอร์คาร์บอนไคลอโร-ไซด์ขนาดพลังงานต่างๆ กัน พบร่วม เมื่อพลังงานของแสงเลเซอร์แบบคิว-สวิทช์ ที่ใช้แอนนีลมีค่าสูงถึงขนาดหนึ่ง ขั้วต่อไฟฟ้าที่ได้จะเป็นขั้วต่อไฟฟ้าที่ดีขึ้น ความด้านทานอนุกรมของขั้วต่อไฟฟ้าจะมีค่าลดลง ผิวของขั้วต่อไฟฟ้าหลังแอนนีลจะสะอาดไม่เป็นฝ้า ทำให้ต่อสายเพื่อนำไปใช้งานได้ดีขึ้น

นอกจากนี้ยังพบว่า เมื่อทำการแอนนีลขั้วต่อไฟฟ้าที่ทำด้วยโลหะนิเกลด้วยแสงเลเซอร์แบบคิลินต์เนื่อง จากเลเซอร์คาร์บอนไคลอโร-ไซด์ และแสงเลเซอร์แบบคลีนต์เนื่องจากเย็คเลเซอร์ ที่พลังงานขนาดต่างๆ กันพบว่า กรณีใช้แสงเลเซอร์คาร์บอนไคลอโร-ไซด์แบบคลีนต์เนื่องนั้น ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีน้อยกว่ากรณีที่แอนนีลด้วยแสงเลเซอร์แบบคิว-สวิทช์ จากเลเซอร์คาร์บอนไคลอโร-ไซด์

แต่สำหรับกรณีที่แอนนิลด้วยเลเซอร์เย็บนั้น ในส่วนของไบแอสต์รัง (Forward bias) ผลที่ได้เหมือนกับที่เกิดขึ้นเมื่อแอนนิลด้วยเลเซอร์คราวบอนไดออกไซด์ แต่ในส่วนไบแอสกลับ (Reverse bias) พบว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าพังทลาย (Breakdown voltage) มีค่าสูงขึ้น 3 เท่า แสดงให้เห็นว่าแสงเลเซอร์ของเลเซอร์เย็บ ซึ่งมีความยาวคลื่น 1.06 ไมโครเมตร มีผลของการแอนนิลได้สูงกว่า เนื่องจากมีพังงานโฟต่อนที่ match กับช่วงพังงาน (Energy gap) ของสารกึ่งตัวนำได้ดีกว่า จึงเกิดการอุดกั้นพังงานได้มากกว่า



ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย